

TEMA 6: EL TRANSISTOR MOS

6.1. Estructura física.

6.1.1 *Estructura Metal Oxido Semiconductor (MOS)*

6.1.2 *El transistor MOS de enriquecimiento: de canal N y de canal P*

6.1.3 *El transistor MOS de empobrecimiento: de canal N y de canal P.*

6.2. Regiones de operación.

6.2.1 *Región de corte.*

6.2.2 *Región lineal u óhmica.*

6.2.3 *Región saturación.*

6.3. El transistor MOS como elemento de circuito:

6.3.1 *Variables de circuito y configuraciones básicas:*

- *drenador común,*
- *fuente común*
- *puerta común.*

6.3.2 *Curvas características y modelos básicos.*

6.3.3 *Circuitos con transistores: Cálculo del punto de trabajo.*

6.4. Familias lógicas MOS.

6.4.1 *Familias NMOS: Puertas Lógicas y Funciones Booleanas*

6.4.2 *Familia CMOS: Puertas Lógicas y Funciones Booleanas*

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

- **Fernández Ramos, J. y otros, "Dispositivos Electrónicos para Estudiantes de Informática" Universidad de Málaga / Manuales 2002. Tema 6: pag. 135- 176.**
- **Malik, N.R., "Circuitos Electrónicos. Análisis, Simulación y Diseño", Editorial Prentice-Hall 1996. Tema: 5: pag. 291-311, 317-322, y Tema 13: 932-950**
- **Daza A. y García J. "Ejercicios de Dispositivos Electrónicos" Universidad de Málaga/Manuales 2003. Tema 4: pag 169-252.**
- **<http://jas.eng.buffalo.edu/education/index.html>**
- **<http://tech-www.informatik.uni.hamburg.de/applets/cmossedemo.html>**